2SA883

PNP エピタキシアル形シリコントランジスタ／PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅，中速度スイッチング用／

High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching

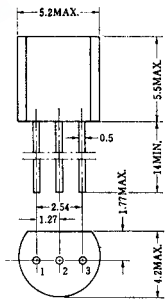
通信工業用／Industrial Use

2SA883 は，通信工業用モールドトランジスタシリーズ（新シリーズ）の一環として開発されたトランジスタで，特に高信頼度設計がなされており，計測器，端末機器等通信工業用分野に最適です。

特　徴／FEATURES

- 高周波増幅はもとより，スイッチング，低周波増幅など，広範囲な回路に使用できます。
  Suituble for switching and audio amplifier as well as high frequency amplifier.
- 電源電圧の変動に対して余裕がある。V_{CEO}：−40V
  Keeps stabilized operation against power voltage fluctuation.
- 従来の拡散形トランジスタにくらべ，ベース逆バイアスを深くかけることができる。V_{EBO}：−8.0V
  Available for deeper base reverse bias than with normal diffused transistors.
- 直流電流増幅率が高い。h_{FE}：160TYP（I_C＝−10mA）
  High DC current gain.

外形図／PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)



絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS（T_a＝25℃）

項　目	略　号	定　格	単　位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−8.0	V
コレクタ電流	I_C	−200	mA
全損失	P_T	300	mW
ジャンクション温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−65〜+150	℃

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS（T_a＝25℃）

項　目	略　号	条　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}＝−40V，I_E＝0			−100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}＝−5.0V，I_C＝0			−100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	V_{CE}＝−1.0V，I_C＝−10mA	80	160	320	
直流電流増幅率	h_{FE2}	V_{CE}＝−1.0V，I_C＝−100mA	40	80		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C＝−100mA，I_B＝−10mA		−0.2	−0.6	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C＝−100mA，I_B＝−10mA		−0.9	−1.2	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}＝−10V，I_E＝10mA	150	280		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	V_{CB}＝−10V，I_E＝0，f＝1.0MHz		7.5	10	pF
ターンオン時間	t_{on}	測定回路図参照/See test circuit		100		ns
蓄積時間	t_{stg}			200		ns
ターンオフ時間	t_{off}			270		ns

EEPW 電子產品世界 .com.cn